

## Transistor Mosfet FQPF8N60C 600V 7.5A

Codigo: 113786



### Descripción

El FQPF8N60C es un Mosfet ha sido especialmente diseñada para minimizar la resistencia en el estado, proporcionar un rendimiento de conmutación superior y soportar pulsos de alta energía en el modo de conmutación y avalancha. Estos dispositivos son adecuados para suministros de energía de modo de conmutación de alta eficiencia y corrección de factor de potencia activa.

- Capacidad  $dv / dt$  mejorada
- Cambio rápido
- Carga de puerta baja (típico 28 nC)
- Crss bajo (típico 12 pF)
- Polaridad del transistor: Canal N
- Voltaje de drenaje a fuente VDS: 600 V
- Voltaje de puerta a fuente: VGS  $\pm$  30 V
- Corriente de drenaje ID: 7.5 A
- Corriente de drenaje pulsada: 30 A
- Disipación de potencia (Tc=25°C): 48 W
- Resistencia de activación Rds(on): 1.2 ohm
- Temperatura de operación mínima: -55 °C
- Temperatura de operación máxima: 150 °C
- Encapsulado: TO-220F
- Número de pines: 3